

DIODA LASEROWA RLD – 635 (5)

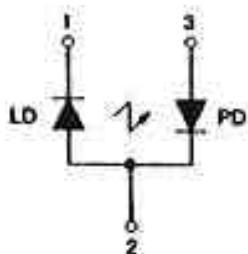
635 nm, 5 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda na podłożu InGaAlP z fotodiody monitorującą, emitowana długość fali 635 nm, obudowa TO-18, ? 5.6mm

Parametry optyczne i elektryczne (T_o=25 °C)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-------------------|------|----------|-----|-----------|
| Długość fali | ? | 632 | 636 | 640 | nm |
| Emitowana moc | P ₀ | 5 | 5 | | mW |
| Prąd progowy | I _{th} | | 25 | 30 | mA |
| Prąd pracy diody | I _{op} | | 40 | 45 | mA |
| Napięcie pracy diody | V _{op} | | 2.3 | 2.7 | V |
| Rozbieżność wiązki | ??? | | 8 | 10 | stopnie |
| Rozbieżność wiązki | ?? | | 35 | 40 | stopnie |
| Prąd monitorowania | I _s | 0.01 | 0.03 | 0.1 | mA |
| Napięcie zwrotne diody | V _{R LD} | | 2 | | V |
| Napięcie zwrotne fotodiody | V _{R PD} | | 30 | | V |
| Temperatura pracy | T _o | | -10 ~ 40 | 50 | °C |
| Temperatura magazynowania | T _{STG} | | -40 ~ 85 | | °C |

Typ połączeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodiody monitorująca

Uwaga: Element czuły na narazenia elektrostatyczne. Zachować niezbędną ostrożność przy przechowywaniu i operacjach montażu.

Dioda laserowa RLD – 635 (5)

DIODA LASEROWA RLD – 635 (10)

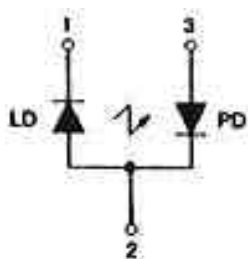
635 nm, 10 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda na podłożu InGaAlP z fotodiody monitorującą, emitowana długość fali 635 nm, obudowa TO-18, ? 5.6mm

Parametry optyczne i elektryczne (T_c=25 °C)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-------------------|------|----------|-----|-----------|
| Długość fali | ? | 632 | 637 | 640 | nm |
| Emitowana moc | P ₀ | 5 | 10 | 10 | mW |
| Prąd progowy | I _{th} | | 30 | 35 | mA |
| Prąd pracy diody | I _{op} | | 45 | 50 | mA |
| Napięcie pracy diody | V _{op} | | 2.3 | 2.7 | V |
| Rozbieżność wiązki | ??? | | 8 | 10 | stopnie |
| Rozbieżność wiązki | ?? | | 35 | 40 | stopnie |
| Prąd monitorowania | I _s | 0.01 | 0.03 | 0.1 | mA |
| Napięcie zwrotne diody | V _{RLD} | | 2 | | V |
| Napięcie zwrotne fotodiody | V _{R PD} | | 30 | | V |
| Temperatura pracy | T _o | | -10 ~ 40 | | °C |
| Temperatura przechowywania | T _{STG} | | -40 ~ 85 | | °C |

Typ połączeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodiody monitorująca

Uwaga: Element czuły na narazenia elektrostatyczne. Zachować niezbędną ostrożność przy przechowywaniu i operacjach montażu.

Dioda laserowa RLD – 635 (10)

DIODA LASEROWA RLD – 635 (20)

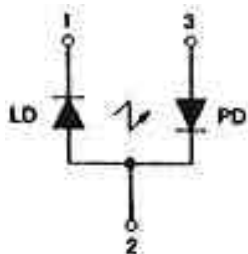
635nm, 20 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda laserowa emitująca fale o długości 635 nm z fotodiody monitorującej, obudowa TO-18, ? 5.6mm

Parametry optyczne i elektryczne (T_c=25 °C)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-------------------|------|----------|------|-----------|
| Długość fali | ? | | 635 | 640 | nm |
| Emitowana moc | P ₀ | | 20 | | mW |
| Prąd progowy | I _{th} | | 50 | 60 | mA |
| Prąd pracy diody | I _{op} | | 70 | 85 | mA |
| Napięcie pracy diody | V _{op} | | 2.3 | 2.7 | V |
| Rozbieżność wiązki | ??? | 6 | 8 | 10 | Stopnie |
| Rozbieżność wiązki | ?? | 20 | 25 | 35 | Stopnie |
| Prąd monitorowania | I _s | 0.01 | 0.03 | 0.08 | mA |
| Napięcie zwrotne diody | V _{R LD} | | 2 | | V |
| Napięcie zwrotne fotodiody | V _{R PD} | | 30 | | V |
| Temperatura pracy | T _o | | -10 ~ 40 | | °C |
| Temperatura przechowywania | T _{STG} | | -40 ~ 85 | | °C |

Typ połączeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodiody monitorująca

Uwaga: Element czuły na narazenia elektrostatyczne. Zachować niezbędną ostrożność przy przechowywaniu i operacjach montażu.

Dioda laserowa RLD – 635 (20)

DIODA LASEROWA RLD – 650 (5)

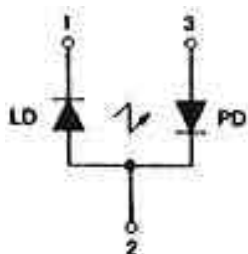
650 nm, 5 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda na podłożu InGaAlP z fotodiody monitorującą, emitowana długość fali 650 nm, obudowa TO-18, ? 5.6mm.

Parametry optyczne i elektryczne (T_c=25 °C)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-------------------|------|----------|-----|-----------|
| Długość fali | ? | | 650 | 660 | nm |
| Emitowana moc | P ₀ | | 5 | | mW |
| Prąd progowy | I _{th} | | 25 | 40 | mA |
| Prąd pracy diody | I _{op} | | 32 | 45 | mA |
| Napięcie pracy diody | V _{op} | | 2.2 | 2.6 | V |
| Rozbieżność wiązki | ??? | 6 | 9 | 13 | stopnie |
| Rozbieżność wiązki | ?? | 22 | 29 | 38 | stopnie |
| Prąd monitorowania | I _s | 0.05 | 0.1 | 0.3 | mA |
| Napięcie zwrotne diody | V _{RLD} | | 2 | | V |
| Napięcie zwrotne fotodiody | V _{R PD} | | 30 | | V |
| Temperatura pracy | T _o | | -10 ~ 40 | | °C |
| Temperatura przechowywania | T _{STG} | | -40 ~ 85 | | °C |

Typ połączeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodiody monitorująca

Uwaga: Element czuły na narazenia elektrostatyczne. Zachować niezbędną ostrożność przy przechowywaniu i operacjach montażu.

Dioda laserowa RLD – 650 (5)

DIODA LASEROWA RLD – 650 (30)

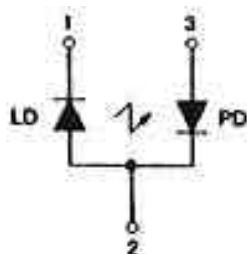
650 nm, 30 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda na podłożu InGaAlP z fotodiody monitorującą, emitowana długość fali 650 nm, obudowa TO-18, ? 5.6mm.

Parametry optyczne i elektryczne ($T_c=25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-----------|------|----------|-----|--------------------|
| Długość fali | ? | | 650 | 660 | nm |
| Emitowana moc | P_0 | | 30 | | mW |
| Prąd progowy | I_{th} | | 25 | 30 | mA |
| Prąd pracy diody | I_{op} | | 40 | 45 | mA |
| Napięcie pracy diody | V_{op} | | 2.3 | 2.7 | V |
| Rozbieżność wiązki | ??? | 6 | 8 | 13 | stopnie |
| Rozbieżność wiązki | ?? | 22 | 33 | 38 | stopnie |
| Prąd monitorowania | I_s | 0.05 | 0.3 | 0.6 | mA |
| Napięcie zwrotne diody | V_{RLD} | | 2 | | V |
| Napięcie zwrotne fotodiody | V_{RPD} | | 30 | | V |
| Temperatura pracy | T_o | | -10 ~ 40 | | $^{\circ}\text{C}$ |
| Temperatura przechowywania | T_{STG} | | -40 ~ 85 | | $^{\circ}\text{C}$ |

Typ połączeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodiody monitorująca

Uwaga: Element czuły na narazenia elektrostatyczne. Zachować niezbędną ostrożność przy przechowywaniu i operacjach montażu.

Dioda laserowa RLD – 650 (30)

DIODA LASEROWA RLD – 785 (70)

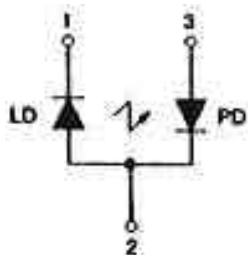
785 nm, 70 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda wysokiej mocy z fotodiody monitorujaca, emitowana dlugosc fali 785 nm, obudowa TO-18, ? 5.6mm.

Parametry optyczne i elektryczne (T_c=25 oC)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-------------------|-----|----------|-----|-----------|
| Dlugosc fali | ? | | 785 | | nm |
| Emitowana moc | P ₀ | | 70 | | mW |
| Prad progowy | I _{th} | | 30 | 50 | mA |
| Prad pracy diody | I _{op} | | 100 | 140 | mA |
| Napiecie pracy diody | V _{op} | | 2.2 | 2.5 | V |
| Rozbieznosc wiązki | ??? | 5.5 | 7 | 8 | stopnie |
| Rozbieznosc wiązki | ?? | 15 | 17 | 20 | stopnie |
| Prad monitorowania | I _s | 0.1 | 0.25 | 0.6 | A |
| Napiecie zwrotne diody | V _{R LD} | | 2 | | V |
| Napiecie zwrotne fotodiody | V _{R PD} | | 15 | | V |
| Temperatura pracy | T _o | | -10 ~ 40 | | oC |
| Temperatura przechowywania | T _{STG} | | -40 ~ 85 | | oC |

Typ polaczeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodiody monitorujaca

Uwaga: Element czuly na narazenia elektrostatyczne. Zachowac niezbedna ostroznosc przy przechowywaniu i operacjach montazu.

Dioda laserowa RLD – 785 (80)

DIODA LASEROWA RLD – 808 (200)

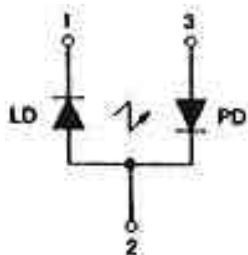
808 nm, 200 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda podczerwona, emitowana dlugosc fali 808 nm z fotodiody monitorujaca, obudowa TO-18, ? 5.6mm.

Parametry optyczne i elektryczne (T_c=25 °C)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-------------------|-----|----------|-----|-----------|
| Dlugosc fali | ? | 803 | 808 | 811 | nm |
| Emitowana moc | P ₀ | | 200 | | mW |
| Prad progowy | I _{th} | | 150 | 200 | mA |
| Prad pracy diody | I _{op} | | 350 | 500 | mA |
| Napiecie pracy diody | V _{op} | | 1.9 | 3.0 | V |
| Rozbieznosc wiązki | ??? | | 12 | 17 | stopnie |
| Rozbieznosc wiązki | ?? | | 28 | 40 | stopnie |
| Prad monitorowania | I _s | | 0.3 | | mA |
| Napiecie zwrotne diody | V _{R LD} | | 2 | | V |
| Napiecie zwrotne fotodiody | V _{R PD} | | 15 | | V |
| Temperatura pracy | T _o | | -10 ~ 40 | | °C |
| Temperatura przechowywania | T _{STG} | | -40 ~ 85 | | °C |

Typ polaczeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodiody monitorujaca

Uwaga: Element czuly na narazenia elektrostatyczne. Zachowac niezbedna ostroznosc przy przechowywaniu i operacjach montazu.

Dioda laserowa RLD – 808 (200)

DIODA LASEROWA RLD – 808 (500)

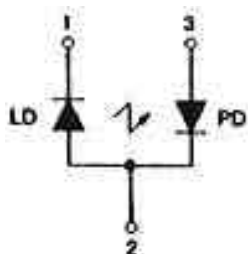
808 nm, 500 mW, ? 5.6mm

Opis: Dioda podczerwona z fotodioda monitorujaca, emitowana dlugosc fali 808 nm, obudowa TO-18, ? 5.6mm.

Parametry optyczne i elektryczne (T_c=25 oC)

| | Symbol | Min | Typowa | Max | Jednostka |
|----------------------------|-------------------|-----|----------|------|-----------|
| Dlugosc fali | ? | 803 | 808 | 811 | nm |
| Emitowana moc | P ₀ | | 500 | | mW |
| Prad progowy | I _{th} | | 180 | | mA |
| Prad pracy diody | I _{op} | | 750 | 1000 | mA |
| Napiecie pracy diody | V _{op} | | 2,1 | 3 | V |
| Rozbieznosc wiazki | ??? | | 8 | 17 | stopnie |
| Rozbieznosc wiazki | ?? | | 30 | 40 | stopnie |
| Prad monitorowania | I _s | | 0.8 | 0.1 | mA |
| Napiecie zwrotne diody | V _{R LD} | | 2 | | V |
| Napiecie zwrotne fotodiody | V _{R PD} | | 15 | | V |
| Temperatura pracy | T _o | | -10 ~ 40 | | oC |
| Temperatura przechowywania | T _{STG} | | -40 ~ 85 | | oC |

Typ polaczeń: N



1. Dioda laserowa
2. Obudowa
3. Fotodioda monitorujaca

Uwaga: Element czuly na narazenia elektrostatyczne. Zachowac niezbedna ostroznosc przy przechowywaniu i operacjach montazu.

Dioda laserowa RLD – 808 (500)